



汕头华汕电子器件有限公司

PNP DIGITAL TRANSISTOR

**HA114T**

对应国外型号

DTA114T, 2SA1497, KSR2210

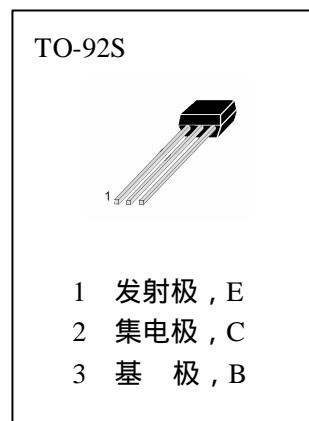
### 主要用途

开关、接口电路等。

### 极限值 ( $T_a=25$ )

$T_{stg}$	——贮存温度.....	-55~150
$T_j$	——结温.....	150
$P_C$	——集电极耗散功率.....	300mW
$V_{CBO}$	——集电极—基极电压.....	-50V
$V_{CEO}$	——集电极—发射极电压.....	-50V
$V_{EBO}$	——发射极—基极电压.....	-5V
$I_C$	——集电极电流.....	-100mA

### 外形图及引脚排列

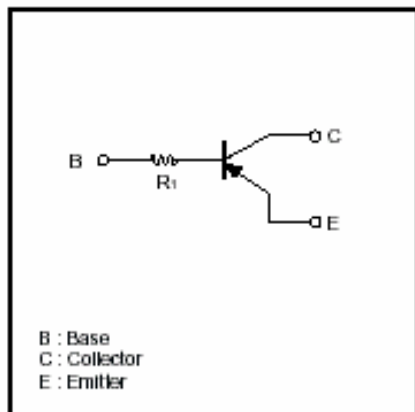


### 电参数 ( $T_a=25$ )

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$BV_{CBO}$	集电极—基极击穿电压	-50			V	$I_C=-50\mu A, I_E=0$
$BV_{CEO}$	集电极—发射极击穿电压	-50			V	$I_C=-1mA, I_B=0$
$BV_{EBO}$	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-50\mu A, I_C=0$
$I_{CBO}$	集电极—基极截止电流			-0.5	$\mu A$	$V_{CB}=-50V, I_E=0$
$I_{EBO}$	发射极—基极截止电流			-0.5	$\mu A$	$V_{EB}=-4V, I_C=0$
HFE	直流电流增益	100	250	600		$V_{CE}=-5V, I_C=-1mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			-0.3	V	$I_C=-10mA, I_B=-1mA$
$V_{I(off)}$	关闭输入电压	-0.4	-0.55	-0.8	V	$V_{CE}=-5V, I_C=-0.1mA$
$V_{I(on)}$	导通输入电压	-0.7	-1.2	-3.0	V	$V_{CE}=-0.2V, I_C=-10mA$
R1	输入电阻	7.0	10	13	k	
$f_T$	特征频率		250		MHz	$V_{CE}=-10V, I_C=-5mA$
Cob	共基极输出电容		3.7		pf	$V_{CB}=-10V, f_T=1MHz$



### 等效电路



### 特性曲线

图 1. 直流电流增益

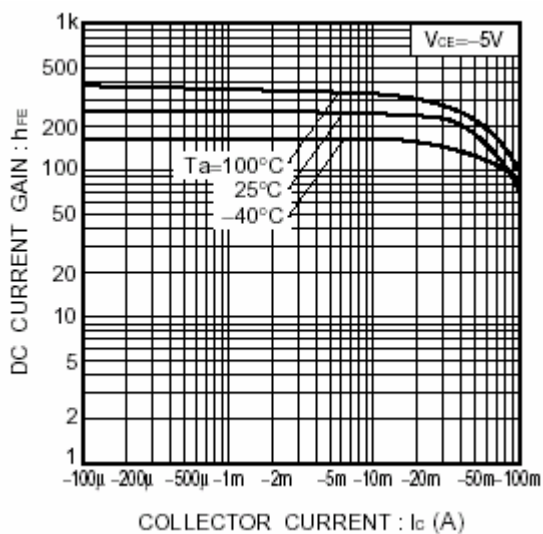


图 2. 集电极—发射极饱和压降

